ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М.А. БОНЧ-БРУЕВИЧА» (СПбГУТ)

Лабораторная работа №4

Исследование свойств модели резисторного каскада с общей базой в частотной и временной областях на ПК

Выполнила бригада:

Группа ИКТЗ-83

Громов А.А., Миколаени М.С., Мазеин Д.С.

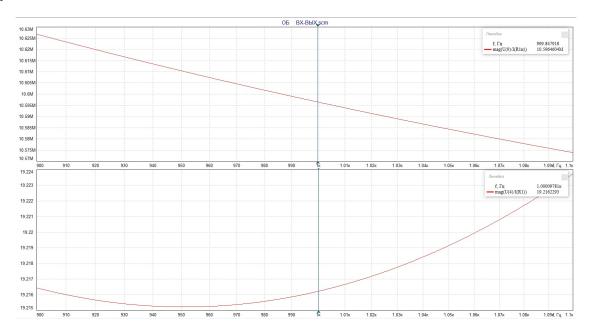
(Ф.И.О., № группы)

(подпись)

Санкт-Петербург

Цель работы: Изучить свойства усилительного каскада с общим коллектором (ОК) в режиме малого сигнала. Выполнить анализ в частотной и временной областях. Исследовать свойства каскада при изменении сопротивлений источника сигнала, нагрузки и элементов схемы. Определить входное и выходное сопротивления каскада.

Пункт 1:

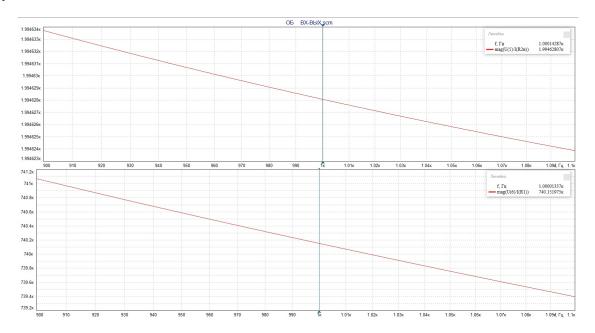


Входное сопротивление с учетом и без учета резистора $R_{\mathfrak{p}}$

Таблица 1: Измерение входного сопротивления каскада с ОК

<u>.</u>				
Измерение	Величина входного сопротивления, КОм			
с учётом сопротивления $R_{\scriptscriptstyle 9}$	10,6 МОм			
без учёта сопротивления $R_{\mathfrak{p}}$	19,2 Ом			

Пункт 2:



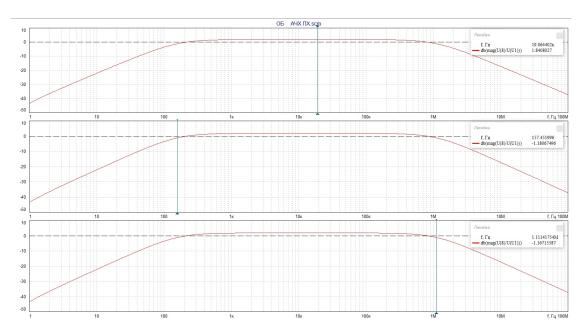
Выходное сопротивление транзистора и каскада

Выходное сопротивление с учетом $R_{\rm 9}$ 1,994 кОм Выходное сопротивление без учета $R_{\rm 9}$ 740,15 кОм

Выводы по пункту 2:

• Входное сопротивление каскада с ОК примерно на 3 порядка больше, чем выходное.

Пункт 3:



АЧХ и ФЧХ каскада

Таблица 2: Измерение АЧХ каскада с ОБ

$K_{\text{скв}}$, Дб	$(K_{\text{скв}}$ - 3), Дб	fн, Гц	fв, МГц	$\Delta f=fв-fн, M\Gamma$ ц
1.84	-1.16	157.45	1,11	1.1098

Выводы по пункту 3:

- Схема с ОК не инвертирует входной сигнал.
- У схемы каскада с ОК рабочая полоса частот больше, чем у схемы с ОЭ.
- Схема каскада с ОК, в отличие от схемы касакада с ОЭ, ослабляет сигнал.

Пункт 4:

Таблица 3: Измерение ПХ каскада с ОК

	ение 11х каскада с ОК			
Время импульса	$t_{\rm H}$ = 25 MKC			
Частота f, Гц	20000			
Осциллограмма импульса	N. 48 May 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
Измеренный спад вершины импульса Δ , % $\Delta = \frac{U_{\rm ycr} - U_{\rm выx}}{U_{\rm ycr}} \cdot 100\%$	2.35			
Рассчитанный спад вершины импульса Δ ,	2.47			
	ой области нарастания импульса			
Измеренное время нарастания импульса	312.8			
Рассчитанное время нарастания импульса $t_{\rm H}$, нс	315.3			
Время импульса	$t_{\rm H} = 1.25 \; {\rm Mc}$			
Частота f, Гц	400			
	рамма импульса			
Измеренный спад вершины импульса Δ , % $\Delta = \frac{U_{\rm ycr} - U_{\rm Bblx}}{U_{\rm ycr}} \cdot 100\%$	71			
Рассчитанный спад вершины импульса Δ , $\%$	124			

Выводы по пункту 4:
• Измеренный спад вершины импульса практически совпадает с рассчитанным спадом вершины импульса;

ное временем	1	3		

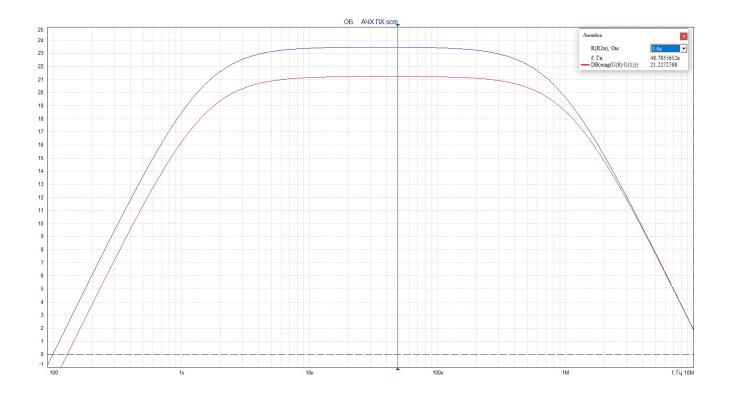
Пункт 5

Таблица 4: Оценка влияния параметров схемы на ПХ и АЧХ

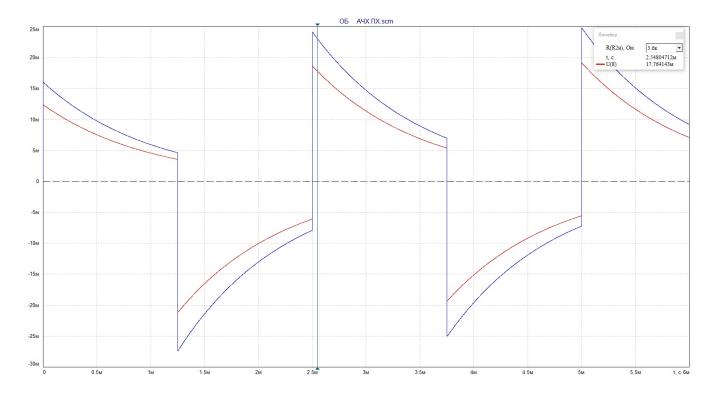
№	R_1	R_2	K_{ckb}	$f_{\scriptscriptstyle m H}$	$f_{\mathtt{B}}$	Δ при $t_{\scriptscriptstyle \mathrm{H}} = 25$ мкс	t_n при $t_{ exttt{ iny I}} = 1.25$ мс
п/п	кОм	кОм	дБ	Гц	МΓц	%	нс
1	1	3.6	1.84	0.16	1.11	71.20	310
2	1	10	4.09	0.16	0.86	71.10	402
3	0.1	3.6	21.228	1.47	1.07	99.56	310
4	0.1	10	23.466	1.46	0.84	99.66	390



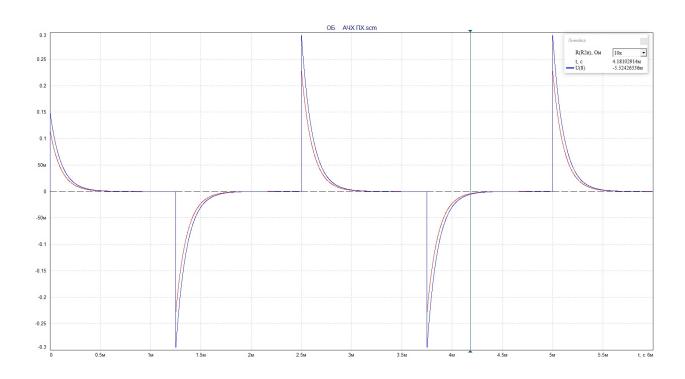
АЧХ при R_1 = 1000 Ом



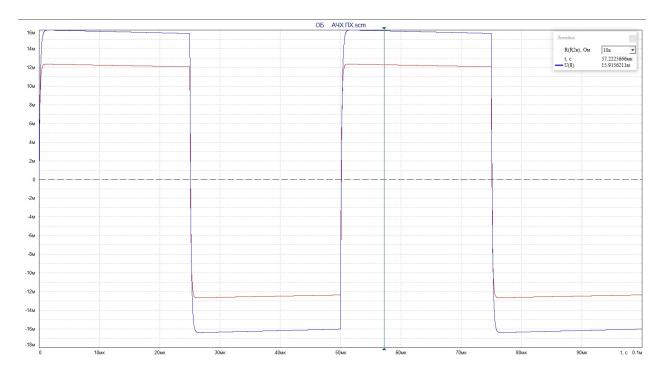
АЧХ при R_1 = 100 Ом



ПХ при R_1 = 1000 Ом, f = 400 Гц



ПХ при R_1 = 10О Ом, f = 400 Гц



ПХ при f = 20 кГц, $R_1 = 1000$ Ом

№	C_{p1}	K	f	f	Δ при $t_{\scriptscriptstyle \rm H}$ = 25 мкс
п/п	мкФ	дБ	кГц	МГц	%
1	1	1.841	158	1109000	71.20
2	10	1.841	15.8	1109000	12.05

Выводы по пункту 5:

- Увеличение R_1 уменьшает измеренный спад вершины импульса и увеличивает $t_{\rm u}$, а увеличение R_2 практически не оказывает эффекта на эти параметры
- Увеличение R_1 уменьшает $K_{\rm ckb}$, а также сдвигает вниз по частоте $f_{\rm H}$ и $f_{\rm B}$ и уменьшает рабочий диапазон частот. Увеличение R_2 незначительно влияет на эти параметры.